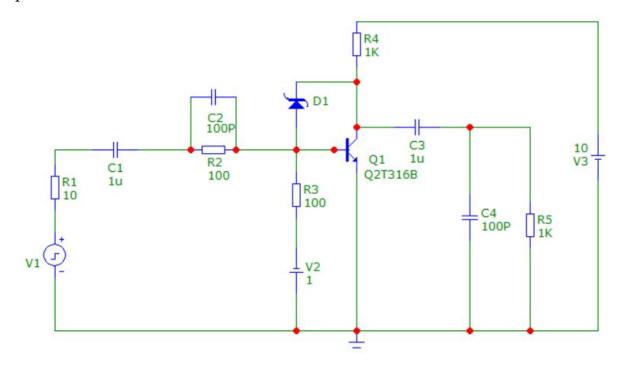
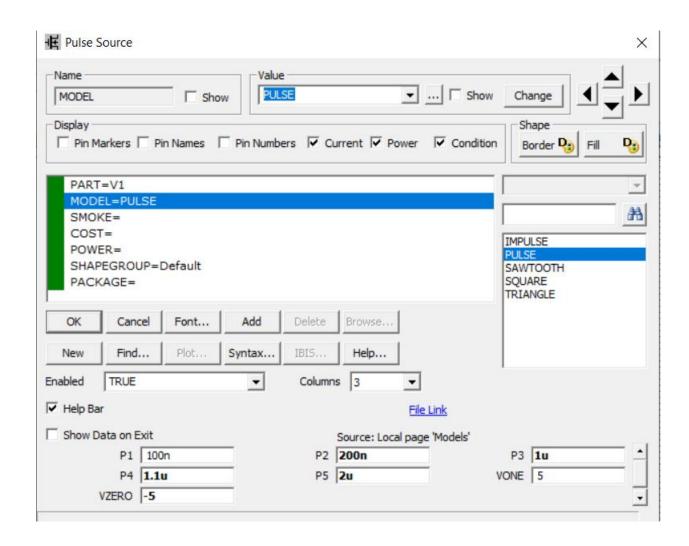
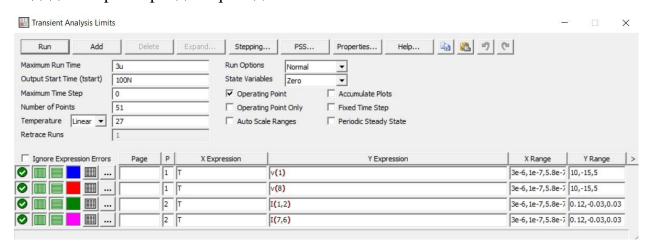
3.1 Анализ по переменному току - исследование временных диаграмм напряжений на входе и на выходе. Определение амплитуды входного импульса, переводящего схему в ключевой режим.



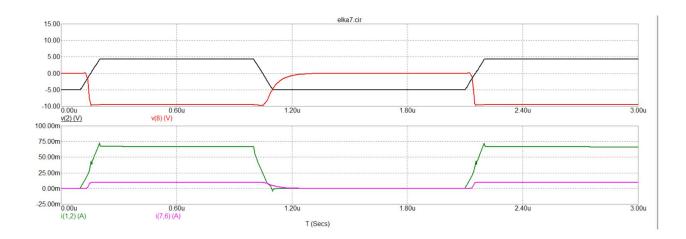
Зададим параметры генератора:



Зададим параметры для проведения анализа.

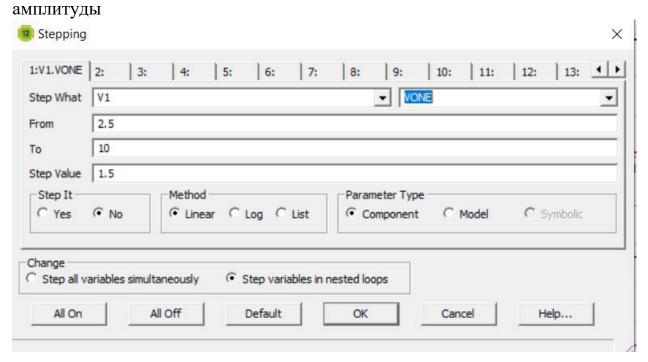


Результаты проведения анализа – временные диаграммы

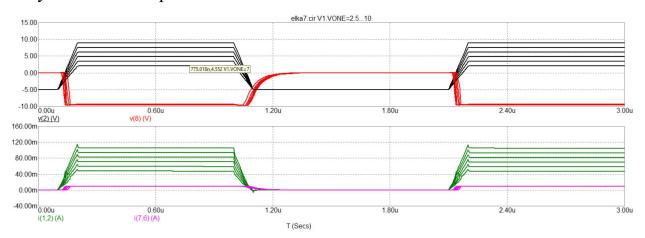


3.2. Многовариантный анализ.

Окно задания многовариантного анализа для исследования изменения амплитуды входного сигнала на



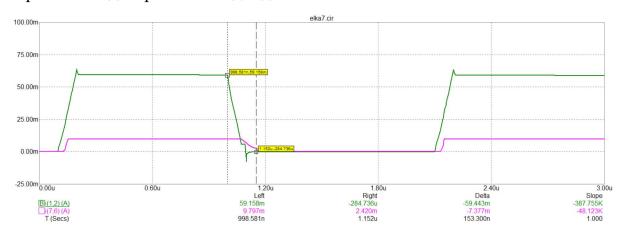
Результат многовариантного анализ



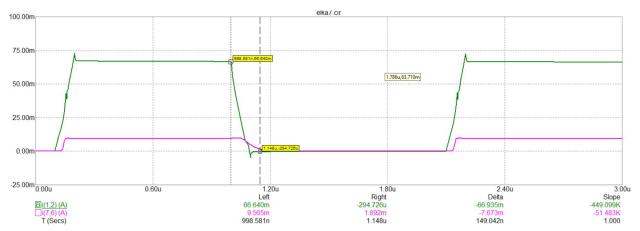
Далее определяется коэффициент насыщения: $K_{\text{нас}} = I_{\text{Бнас}} / I_{\text{Бгр}}$, где $I_{\text{Бнас}}$ - ток насыщения базы, $I_{\text{Бгр}}$ - граничное значение тока баз

3.3. Влияние диода Шотки.

Временные диаграммы без диода Шотки



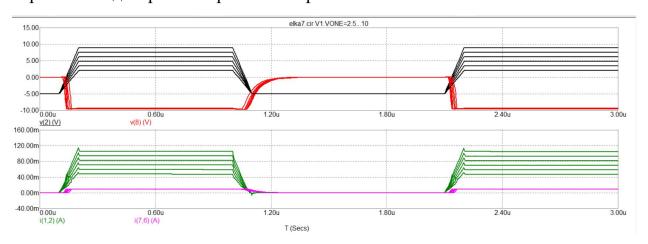
Временные диаграммы с диодом Шотки



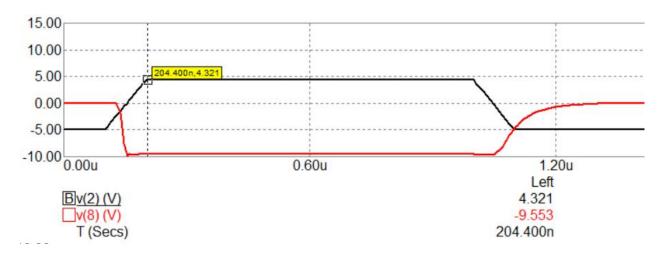
Из временных диаграмм видно, что время рассасывания неосновных носителей без диода $t_{pac} = 154$ нс, а при наличии диода $t_{pac} = 150$ нс (см. Delta). Таким образом, быстродействие увеличивается на 4 нс.

3.4. Определение коэффициента насыщения

Временные диаграммы при многовариантном анализе



Получаем временные диаграммы, представленные на рисунках. Видно, что срабатывание ключа происходит при амплитуде входного импульса V=2,02 В, при этом ток базы $I_6=I_{\rm 6rp}=47,5$ мА.



V, B	I ₆ , MA
2,02	47,5
3,41	58,9
4,79	70,5
6,17	82,1
7,55	93,7
8,94	105,3

Тогда коэффициент насыщения тока базы $K_{\text{\tiny Hac}} = I_{\text{\tiny бнас}}$

$$K_{\text{нас}}$$
 (при $V = 3,41~B$) = $58,9 / 47,5 = 1.24$;

$$K_{\text{нас}}$$
 (при V = 4,79 B) = 70,5/47,5 = 1,48;

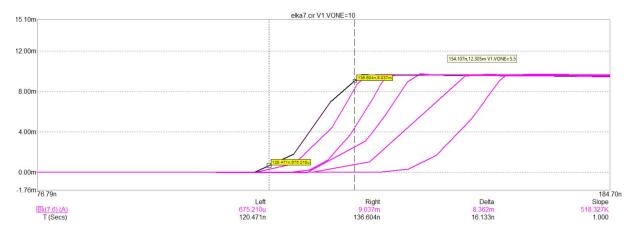
$$K_{\text{нас}}$$
 (при $V = 6,17 \text{ B}$) = 82,1/47,5 = 1,72;

$$K_{\text{нас}}$$
 (при V = 7,55 B) = 93,7/47,5 = 1,97;

$$K_{\text{нас}}$$
 (при V = 8,94 B) = 105,3/47,5 = 2.21

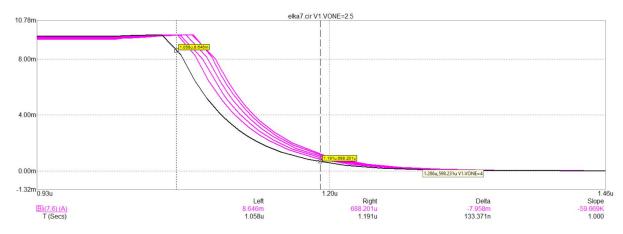
3.5. Определение длительности фронта.

Передние фронты импульсов



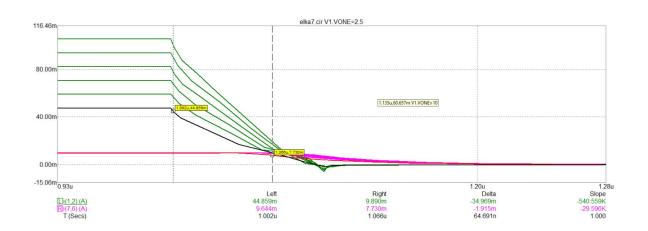
3.6. Определение длительности среза.

Задние фронты импульсов коллекторного тока



3.7. Определение времени рассасывания

Определение времени рассасывания неосновных носителей в базе



3.8. Построение графиков.

По полученным результатам можно составить следующую таблицу.

Кнас	t ф, нс	t c, нс	t pac, HC
1	16	136	56
1,24	24	126	57
1,48	15	119	61
1,72	12	116	65
1,97	15	110	72
2,27	16	112	77

На основании полученных временных диаграмм строятся графики зависимостей t_{ϕ} , t_c и t_{pac} от коэффициента насыщения для тока коллектора, где t_{ϕ} — длительность фронта, t_c — длительность среза и t_{pac} — время рассасывания неосновных носителей в базе.

